

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-2404

(a) Int Cl. 4 H 01 B 1/16 識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)1月8日

01 B 1/16

8222-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称 厚膜ペースト

②特 頤 昭60-139904

20出 頭 昭60(1985)6月26日

@発明者 港田 等

栄 → 東京都新宿区西新

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄化学工業株式会

切発明者 小野 信

社内

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄化学工業株式会

社内

絟

₹1173 -4--4-4--4-4

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 昭栄化学工業株式会

社内

①出 顋 人 昭栄化学工業株式会社

尾

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

射 報 食

1. 発明の名称

⑦発

明

考

厚膜ペースト

2. 特許額求の範囲

1 1種又は2種以上の金属塩を含む溶液を噴霧はして被液にし、その液液を該金属塩の分解温度であって、砂面の酸点より高い温度であって、砂面の酸点以下の温度で金属が酸化物を脂度がある場合にはその酸化物の分解温度より高いを含むになって、砂面で、金属的末年の酸分として用いることを特徴とする摩膜ベースト。

2 金属粉末が単一金属の粉末、合金粉末及びこれらの観合粉末から選ばれる特件請求の範囲第1項記載の厚膜ペースト。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明はエレクトロニクス用序製ペーストに収する。

エレクトロニクス分野において、電子回路や抵

従来の技術

このような厚膜ペーストに使用される金風粉末としては、 従来より金風化合物の溶液に湿元剤を作用させて湿式速元する方法、 金属の溶剤をアトマイズする方法、 あるいは金属を真空中又は不活性ガス中で蒸発させて微粉化する方法で製造されたものなどが使用されている。

<u> 発明が解決しようとする問題点</u>

特開昭62-2404 (2)

厚膜ペーストに受求される一般的な特性は、形成された被膜が概密であること、越板と強固に接着していること、特に導体ペーストの場合、被投表面に 酸化物やガラス質成分が少ないことなどである。

このような特性を満たすために、厚膜ペースト 用金属粉末としては、次のような性質を有するも のが望まれている。

① 観客で均一な被談を形成するため、塗料中で の分散が良好であること。

②不頼物が少いこと。

不輔物が多いと半導体とのオーム接合性、 耐腐食性、耐腐塊性その他の電気特性に悪影響 を及ぼすので、できるだけ低レベルに抑える必 要がある。

②結晶性が良好であること。

特に高温焼成タイプのペーストでは、結晶性が良くないと焼成過程において金属粉末の焼結が早すぎるため溶けたガラス質結合剤が基板側に移行せず、接着強度不良となったり、ガラ

スが関表面に浮いて導電性や半田付け性を聞書するなどの問題を引起こす。従って結晶性が良く、結晶の方向が辿っていることが望ましい。

④ 粒径がほぼ 0.1~10点の範囲で、粒子形状が 揃っていること。

、 を来の湿式速元法により製造された粉末は、種 での形状、粒便のものがあるが、分散性、結晶性 が共に良好でかつ高純度の金銭粉末が得られない。 アトマイズ法では、生成する粉末の粒径が大きく 数粉化が困難であるため、獅くて橄密な被膜が られない。、又種発法では逆に粒径が小さすど、 連料化するのが困難であると共に分散性の良いも のが得られない。

ほってこれらの方法で得られた粉末では、厚設ペーストに要求される種々の特性を満足させるには限界があった。

問題点を解決するための手段

本発明は、1種又は2種以上の金属塩を含む溶 液を噴霧して設演にし、その被病を数金属塩の分

解滅度より高くかつ金属の触点より高い温度でででいる。 って、しかも金属の融点以下の温度で金属が限度で放って、の表合にはその変化物の分解温度で放射することによって製造された金の数末を導電成分として用いることを特徴とする。 粉末を導電成分として用いることを特徴とする原 様ペーストである。尚本発明でいう金属粉末は、 単一金属の粉末、合金粉末及びこれらの複合粉末 をも含むものとする。

作用

本発明の特徴は、導電成分として用いる金風粉末にある。金属の種類としては例えば金、酸、白金、パラジウム等の貴金属や網、ニッケル、コパルト、アルミニウム、モリブデン、タングステン等の卑金属又はこれらの合金など発来から導電成分として使用されているものであればよい。

本発明の厚膜ペーストに使用される粉末を製造するにあたって、金属場としては、加熱分解により目的とする金属を析出するものであればいかなるものでも良く、一例としてこれらの金属の硝酸塩、硫酸塩、塩化物、アンモニウム塩、リン酸塩、

カルボン酸塩、金属アルコラート、側断酸塩など が準けられる。単一金属について異なる複数の塩 を併用することもできる。 2 種以上の金属の塩を 混合使用しても良く、 又被塩や麹塩を使用しても 良い。これら金属塩の1種又は2種以上を、水や、 アルコール、アセトン、エーテル等の有機溶解あ るいはこれらの混合溶解中に溶解し金属塩溶液を を成する。単一の金郎の塩溶液を用いれば純金皿 粉末が得られるが、合金を形成する2種以上の金 興を溶解した溶液を用いれば合金粉末を製造する ことができる。尚疑合する2種以上の金属が合金 を生成しないものであれば、混合粉末が得られる こともある。金異塩溶液は、噴霜器により噴霧し て被摘とし、次いで金属塩の分解塩度より高くか つ金属の離点より高い温度であって、しかも金属 の融点以下の温度で金属が酸化物を形成する場合 にはその世化物の分解温度より高い温度で加熱を 行うことにより、球状で表面の平滑な金属粉末が 生成する。

尚、粉末の製法において加熱温度が金属の融点

特開昭62-2404 (3)

より低温であると、球状粉末ができず、密度も低 いのでペースト用には好ましくない。従って少く とも融点より高温で加熱する必要がある。望まし くは目的金属の融点より100℃以上高温で加熱 を行うのがよい。又金銭塩が分解する原、あるい は分解した後、金属の融点より低い温度で酸化物 を形成するような金属においては、少くとも慈酸 化物が分解する温度まで加悶することが必要であ る。尚、合金を形成する2種以上の金鳳塩を形成 する場合には、加熱塩度は傷の分解温度以上であ ってかつ該金銭を構成成分とする合金の融点より 高い温度であればよい。金属粉末の粒径は金属塩 の遺疫、溶媒の種類及び混合比、噴霧速度、噴霧 彼前の大きさ、及び加熱温度に依存するので、こ れらの条件を適宜設定することにより容易にコン トロールすることができる。特に粒径に直接関係 するとみられる噴霧被筒のサイズについては、噴 難した彼休を更に固体の難容物や回転体に衝突さ せることによって小さくすることができる。又育 媒の独点が低いと加熱時の独職により練着の分裂

が記こり易く、被摘が微幅化するため、生成する 金橋粉末の粒径が小さくなると考えられる。

木苑明の即頃ペーストは、上記製法で得られた 金庫別末を導電成分として用いるもので、常法に 従い、必要に応じて無機結合剤やその他の感加剤 を加え、有機ピヒクル中に均一に分散させたもの である。

上記製法で得られた粉末は結晶性が非常に良く、分散性も極めて良好であるため、この粉末を導置成分としした厚膜ペーストは、薄くて概密かつきる。板と強固に接着した被膜を形成することができる。特に導体ペーストの場合、被膜表面に酸化物やガラス製成分が少なくなるため、半田付け性、ワイヤボンディング性、ダイボンディング性の優れたものが得られる。

実施 例

次に実施例及び比較例をあげて本発明を具体的に説明する。

実態 閉 1

A g NO s 結晶をエタノール 8 0 %を含むエタ

この粉末を用い、以下の配合で導体ペーストを 作成した。

| A g 粉末 | 1000 |
|-----------|------|
| ガラスフリット | 5 0 |
| B i 2 O 3 | 8 g |
| 有機ピヒクル | 300 |

比较强1

加熱温度を900℃とする以外は実施例1と間様にして、Ag 粉末を製造した。以形の粒子は得られず、不定形で最大粒径10㎞、最小粒径1㎞であった。この粉末を用い、実施例1と同一配合で導体ペーストを作成した。

比較别 2

お式遠元法で作った最大粒怪1.5 mm、最小粒径0.5 mmのAg 粉末を用い、実施例1と同一配合で導体ペーストを作成した。

比較試験

実施例1、比較例1及び比較例2で得た3種のペーストをそれぞれアルミナ基板上に印刷し、800で焼成し、通常の摩膜導体の評価方法で試験を行った結果を表1に示す。

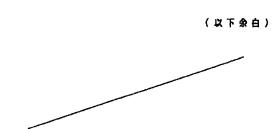


表 1

| 評価項目 | 粘度 | 時性(po | se) | | 半田電性の性 | 接着強度(kg)水 | |
|-------|---------------|--------------|--------------|-----|------------|-----------|--------|
| Ag #9 | 0.4 sec -1 | 4 sec -1 | 40 sec -1 | 印制性 | | 初期 | エージング後 |
| 実施例1 | 8500 | 2300 | 800 | 0 | 良好 | 2.5 | 1,5 |
| 比较例1 | 4000 | 1800 | 800 | x | 良好 | 1.5 | 0.5 |
| 比较例2 | 8000 | 2900 | 1500 | Δ | ピンホ ール有 | 2.0 | 0,9 |

本接着強度は 1.5m□パターンで評価した。 エージング強度は 150℃24時間放置後の値である。

表1から明らかなように、本発明の厚膜ペーストは優れた特性を示す。実施例1のペーストは、スクリーン印刷のためには理想的な貼度特性を有しており、印刷性が良好である。又従来より半田

粉末であった。

この合金粉末を用い、以下の配合で導体ベーストを作成した。

| A 0 / P d | 合金粉末 | 1000 |
|-----------|------|-------|
| 有機ピピク | N | 8 2 g |

このペーストをセラミックシート上に印刷し、 1100℃で焼成したところ、膜厚 1.2 m で穴の 少ない 救密な膜が得られた。比近抗は約20μΩ・mであった。

比较例3

· ·

超式速元法で作った最大粒径1. 5 mi 、最小粒径0. 5 mi のAΦ 粉末及び平均粒径 0.2 mi のPΦ 粉末を用い、以下の配合で導体ペーストを作成した。

| Αg | 粉末 | 8 O g |
|-------------|----------|-------|
| Pđ | 粉末 | 209 |
| Æ 19 | P F A B. | 0.0- |

このペーストをセラミックシート上に印刷し、 1 1 0 0 ℃で焼成したところ、膜厚 1.2 μ1では運 破膜が得られなかった。

実施例2

AのNOI及びPd(NOI)を表、メタノール50%を含むメタノールー水混合溶媒に溶解し、O.50のI/Lの溶液を作った。但しAのNOIとPd(NOI)をの混合初合は、AのとPdの型型比が8:2となるようにした。この溶液を、実態閉1と同様にして、電気炉で1200でに崩熱されたセラミック管中に噴錆し、加集した。野られた粉末は最大粒径2.5mm、風小粒径1.5mmで結晶性の違い表面平滑な球状Aの/Pd合金

变炼例3

HAU CI 4 結偽をエタノールに溶解し、O.5 ™ ol/ 2 の溶液を作成した。この溶液を、実施例2 と同様にして吸熱熱分解し、最大粒径 1. O AM、最小粒径 O.5 AMで結晶性の良い球状 Au 粉末を得た。

この粉末を用い、以下の配合で導体ペーストを 作成した。

| A u 粉末 | 1000 |
|---------|------|
| ガラスフリット | 3 0 |
| CuO | 1 g |
| 有機ピヒクル | 130 |

このペーストをアルミナ塾板上に印刷し、900で焼成したところ、膜厚 7点で緻密な膜が得られた。この膜上にTUS 法でワイヤボンディングを行ったが、2000ショットでボンディング不良は全くなかった。

劝!

実備例からも明らかな通り、本発明のペースト は球状で結晶性が良く、しかも高分散性の金履粉

特開昭62-2404 (5)

末を使用しているため、嫌くて 教密かつ 抵板と強 図に接着した被膜を形成することができる。特に 場体ペーストの複合、被膜 扱面に 酸化物や ガラス 質成分が少なくなるため、半田付け性、ワイヤボ ンディング性、ダイボンディング性の優れたもの が得られる。

特許出願人 昭栄化学工業株式会社

JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT JOURNAL

KOKAI PATENT NO. SHO 62[1987]-2404

Int. cl.4:

H 01 B 1/16

Sequence Nos. for Office Use:

8222-5E

Application No.:

Sho 60[1985]-139904

Application Date:

June 26, 1985

Publication Date:

January 8, 1987

THICK-FILM PASTE

Inventors:

Eiichi Asada, Shinichi Ono, Minoru Matsuo c/o Shoei Kagaku Kogyo K.K., 2-1-1 Nishishiniuku

2-1-1 Nishishinjuku, Shinjukuku, Tokyo

Applicant:

2-1-1 Nishishinjuku, Shinjukuku, Tokyo

Claims

1. Thick-film paste, characterized by using, as an electrically conductive component, metal powders obtained by misting a solution containing one or more metal salts and heating the mist at a temperature higher than the metal salt

decomposition temperature, higher than the metal melting point, and higher than metal oxide decomposition temperature when the metal forms oxide at a temperature below the metal melting point.

2. Thick-film paste of Claim 1, wherein the metal powder is single metal powder, alloy powder, or mixtures thereof.

<u>Detailed explanation of the invention</u>

Industrial utilization field

The present invention concerns thick-film pastes for electronics.

In the electronics field, thick-film pastes such as conductor pastes and resistor pastes have been widely used in the manufacture of electronic circuits, resistors, condensers, IC packages, etc. These pastes contain conductive components such as, noble metals, e.g., gold, silver, platinum, palladium, ruthenium, etc.; base metals, e.g., copper, nickel, aluminum, molybdenum, tungsten, etc., their alloys and oxides, and optionally inorganic binders such as glass and other additives in a uniform paste form in an organic carrier. These pastes are applied on a dielectric plate and baked at high temperature or heat-dried at relatively low temperatures to form conductor or resistor films.

Conventional technology

In general, the metal powders used in such thick-film pastes are prepared through wet reduction by treating a metal compound solution with a reducing agent, atomizing molten metal, or fine powdering by evaporation of a metal in vacuum or an inert gas.

The general characteristics required for thick-film pastes are compactness, good adhesion on substrates, and low surface oxide or glass content, especially in the case of conductors.

To satisfy such characteristics, the metal powders used in thick-film pastes should have the following properties:

- (1) Good dispersibility in coating materials for uniform compact-film formation.
- (2) Low impurity content.

The lowest possible impurity content is needed, since the impurities show adverse effects on the ohmic bonding to semiconductors, the corrosion resistance, the environment resistance, and other electrical properties.

(3) Good crystallinity.

In the firing process, if the crystallinity is poor, the metal powders sinter fast, especially in pastes fired at high temperatures and the molten glass binder does not migrate toward the substrate, resulting in poor adhesion; the glass floats on the film surface, impairing the electric conductivity and solderability. Therefore, good crystallinity and crystals oriented in one direction are desirable.

(4) Particle size in the 0.1-10- μm range, with uniform particle shape.

Powders obtained by a conventional wet-reduction process are of various shapes and sizes; this process does not provide highly pure metal powders with good dispersibility as well as crystallinity. The atomization process provides powders in large sizes and fine powdering is difficult, thus thin compact films cannot be attained. The evaporation method provides powder too

small in size, using them to make pastes with good dispersion is difficult.

Therefore, powders obtained by these methods are only marginally successful in satisfying the characteristics required for the thick-film pastes.

Means for solving the problems

The present invention is a thick-film paste, characterized by using, as an electrically conductive component, metal powders obtained by misting a solution containing one or more metal salts and heating the mist at a temperature higher than the metal salt decomposition temperature, higher than the metal melting point, and higher than metal oxide decomposition temperature when the metal forms an oxide at a temperature below the metal melting point. In the present invention, metal powder means a powder of a single metal, alloys, and mixtures thereof.

Action

The characteristics of the present invention are related to the metal powders used as conductive components. Such metals include noble metals such as gold, silver, platinum, palladium, etc.; base metals such as copper, nickel, cobalt, aluminum, molybdenum, tungsten, etc., and alloys thereof, which have been used as conductive components in conventional methods.

In the manufacture of powders used in thick-film pastes in the present invention, any metal salts can be used if they deposit the desired metals upon thermal decomposition; metal nitrates, sulfates, chlorides, ammonium salts, phosphates, carboxylates, alcoholates, resin-acid salts, etc. Many different salts of a single metal may be used together, or double and complex salts may also be used. One or more of such metal salts are dissolved in a single or mixed solvents chosen from water, alcohol, acetone, ethers, etc. to form metal-salt solutions. A pure metal powder is obtained when a single metal salt is used, while an alloy powder is obtained when a solution of salts of two or more metals that form alloys is used. When those metals are not alloy-forming, mixed powders are obtained. The metal solutions are formed into a mist and heated at a temperature higher than the metal salt decomposition temperature and higher than the metal melting point, or higher than the metal-oxide decomposition temperature when the metal forms an oxide at a temperature below the metal melting point, to give spherical metal powders with a smooth surface.

In the manufacture of powder, temperatures below the metal melting point produce nonspherical powders with low density, and not suitable for pastes. Thus, the heating temperature must be higher than the metal melting point. Desirably, the heating should be performed at a temperature about 100°C higher than the melting point of the desired metal. For metals forming oxides at a temperature below the metal melting point during or after metal-salt decomposition, the heating must be done at a temperature higher than the metal-oxide decomposition temperature. For mixed salts of two or more metals that form alloys, heating must be done at a temperature higher than the metal-salt decomposition temperatures and also higher than the melting point of the resulting alloy. The size of the metal powder is dependent upon the metal-salt concentration, the types and mixing ratio of solvents, misting speed, mist size, heating temperature, etc.; the powder size can be thus controlled easily by the appropriate selection of such conditions. The mist size,

especially, seems to be directly related to the metal-powder size, mist droplets can be further divided by colliding such droplets with a solid obstacle or a rotating body. When the solvent boiling point is low, boiling during the heating further divides the mist droplets, and produces metal powder very small in size.

The thick-film pastes of the present invention utilize metal powders obtained by the process above, as the conductive components, together with optional inorganic binders and other additives, and uniformly disperses them in organic carriers.

The metal powders obtained by this process have excellent crystallinity and dispersibility. Thick-film pastes using such powders as the conductive components form thin compact films with excellent substrate adhesion. Especially, in the case of conductor pastes, the films have very low oxide and glass content on the surface, thus solderability and, wire- and die-bonding properties are good.

Application examples

The present invention is explained below in detail, with application examples and comparative examples.

Application Example 1

A solution of 0.5 mol/L was obtained by dissolving AgNO₃ crystals in aqueous ethanol with an ethanol content of 80%. A mist was formed from a double-wall tubular misting machine by discharging the above solution at a rate of 2.0 mL/min through the inner cylinder of a two-fluid nozzle and compressed air through the outer cylinder at a rate of 10 L/min. When mist was

made in a ceramic tube in an electric furnace at 1100°C, air was fed at a rate of 20 L/min outside the two-fluid nozzle to lead the mist into the heating zone where the mist was thermally decomposed. The product was collected by a cyclone and glass filter. The powder obtained was perfectly spherical, smoothsurfaced Ag with good crystallinity, a maximum particle diameter of 1.7 μ m, a minimum particle diameter of 0.5 μ m.

A conductor paste was prepared using this powder as shown below.

| Ag powder | 100 | g |
|--------------------------------|-----|---|
| Glass frit | 5 | g |
| Bi ₂ O ₃ | 8 | g |
| Organic carrier | 30 | g |

Comparative Example 1

Application Example 1 was repeated at 900°C to obtain an Ag powder that was nonspherical and irregular and had maximum particle diameter of 10 μ m and a minimum particle diameter of 1 μ m. A conductive paste was prepared using this powder with a composition similar to Application Example 1.

Comparative Example 2

Ag powder with a maximum particle diameter of 1.5 μm and a minimum particle diameter of 0.5 μm by the wet reduction method and used in a conductor paste with a composition similar to Application Example 1.

Comparative tests

The pastes of Application Example 1 and Comparative Examples 1 and 2 were printed separately on an alumina substrate and fired at 800°C to obtain thick-film conductors which were tested by usual manner and the results are given in Table I.

Table I.

| Test items | | characteri oise) | stics | Print- | Solder wetting | Adhesive scrength (kg)* | | |
|--------------------------|--------|---------------------|--------|---------|-------------------|-------------------------|---------------|--|
| | 0.4 | 4 | 40 | ability | | Initial | After aging ' | |
| Ag poyder | sec -1 | sec -1 | sec -1 | | | | | |
| Application Example ! | 8500 | 2300 | 800 | 0 | Good | 2.5 | 1.5 | |
| Comparative Example 1 | 4000 | 1800 | 800 | X | Good | 1.5 | 0.5 | |
| Comparative Example 2 | 8000 | 2900 | 1500 | Δ | Pinholes | 2.0 | 0.9 | |

*Adhesive strength was evaluated for a 1.5-mm square pattern. Aging strength was measured after being stored 24 h at 150°C.

Table I clearly shows the superior characteristics of the thick-film paste of the present invention. The paste of Application Example 1 had viscosity characteristics ideal for good screen printability. While solder wetting and adhesive strength are two mutually contradicting characteristics, the

1

paste of Application Example 1 was superior to the powder obtained by wet reduction process in both solder wetting and adhesive strength. The Ag powder did not agglomerate and dispersed well in the paste, resulting in dense films. Good crystallinity of each particle delay sintering during the pastefiring process, resulting in smooth migration of glass to the substrate.

Application Example 2

A solution of 0.5 mol/L was obtained by dissolving AgNO₃ and Pd(NO₃)₂ at an Ag to Pd ratio of 8:2 in aqueous methanol containing 50% methanol. This solution was misted in a ceramic tube in an electric furnace at 1200°C as in Application Example 1. The product was a smooth-surfaced spherical Ag/Pd alloy with good crystallinity, a maximum particle diameter of 2.5 μ m and a minimum particle diameter of 1.5 μ m.

Using this alloy powder, a conductor paste was prepared by the following composition.

Ag/Pd alloy powder 100 g Organic carrier 82 g

This paste was printed on a ceramic sheet and fired at 1100°C to obtain a compact film of 1.2 μm in thickness and a specific resistance about 20 $\mu\Omega/cm$.

Comparative Example 3

Ag powder having a maximum particle diameter of 1.5 μm and a minimum particle diameter of 0.5 μm and Pd powder having an average particle diameter of 0.2 μm were used for a conductor paste at the following composition.

Ag powder 80 g Pd powder 20 g Organic carrier 82 g

This paste was printed on a ceramic sheet and fired at 1100°C to give a continuous film of 1.2 μ m in thickness.

Application Example 3

A solution of 0.5 mol/L was prepared by dissolving HAuCl₄ crystals in ethanol. This solution was then misted and thermally decomposed as in Application Example 2 to obtain a spherical Au powder with good crystallinity, a maximum particle diameter of 1.0 μ m and a minimum particle diameter of 0.5 μ m.

This powder was used for making a conductor paste with the following composition.

| Au powder | 100 | g |
|-----------------|-----|---|
| Glass frit | 3 | g |
| CuO | 1 | g |
| Organic carrier | 13 | g |

This paste was printed on an alumina substrate and fired at 900°C to give a $7-\mu m$ -thick compact film which was then tested for wire bonding by the TUS method, giving no failure in 2000 shots:

Effects

As shown in the application examples, the pastes of the present invention use spherical metal powders with good crystallinity and high dispersibility, producing thin compact films with strong adhesion to substrates. Especially in the case

of conductor pastes, the film surfaces have a very low contents of oxides or glass, thus providing good solderability and, wireand die-bonding properties.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| ☐ BLACK BORDERS |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| OTHER: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

This Page Blank (uspto)